

Brevet N°

84519

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

du 10 décembre 1982

Titre délivré :

28 FEV. 1983



Monsieur le Ministre
de l'Économie et des Classes Moyennes
Service de la Propriété Intellectuelle
LUXEMBOURG

OEB

Demande de Brevet d'Invention

I. Requête

La société dite : SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND (1)
MUNCHEN, Wittelsbacherplatz 2, D- 8000 MUNCHEN 2 (République
Fédérale d'Allemagne), représentée par Monsieur Jacques de (2)
Muyser, agissant en qualité de mandataire

dépose(nt) ce dix décembre 1900 quatre vingt deux (3)
à 15 heures, au Ministère de l'Économie et des Classes Moyennes, à Luxembourg :

1. la présente requête pour l'obtention d'un brevet d'invention concernant : (4)
" Verfahren zum Herstellen polykristalliner, für nachfolgendes
Zonenschmelzen geeigneter Siliciumstäbe. "

2. la délégation de pouvoir, datée de Munchen le 6.12.1982
3. la description en langue allemande de l'invention en deux exemplaires;
4. 1 planches de dessin, en deux exemplaires;
5. la quittance des taxes versées au Bureau de l'Enregistrement à Luxembourg,
le 10 décembre 1982

déclare(nt) en assumant la responsabilité de cette déclaration, que l'(es) inventeur(s) est (sont) :
- Alfred MÜHLBAUER, Westerfeldweg 38, D- 3002 WEDEMARK 2, (5)
République Fédérale d'Allemagne

revendique(nt) pour la susdite demande de brevet la priorité d'une (des) demande(s) de
(6) brevet déposée(s) en (7) République Fédérale d'Allemagne
le 28 mai 1982 sous le No. P 32 20 285.7 (8)

au nom de la déposante (9)

élit(élisent) pour lui (elle) et, si désigné, pour son mandataire, à Luxembourg
35, boulevard Royal (10)

sollicite(nt) la délivrance d'un brevet d'invention pour l'objet décrit et représenté dans les
annexes susmentionnées, — avec ajournement de cette délivrance à / mois. (11)

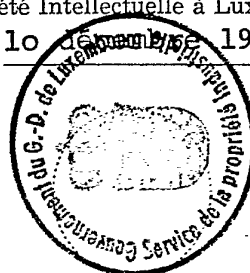
Le mandataire

II. Procès-verbal de Dépôt

La susdite demande de brevet d'invention a été déposée au Ministère de l'Économie et des
Classes Moyennes, Service de la Propriété Intellectuelle à Luxembourg, en date du :

10 décembre 1982

à 15 heures



Pr. le Ministre
de l'Économie et des Classes Moyennes,
p. d.

BEANSPRUCHUNG DER PRIORITÄT

der Patent/~~Gem~~ - Anmeldung

In: DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Vom: 28. Mai 1982

PATENTANMELDUNG

in

Luxemburg

Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MÜNCHEN

Betr.: " Verfahren zum Herstellen polykristalliner, für nachfolgendes
Zonenschmelzen geeigneter Siliciumstäbe."

5 Verfahren zum Herstellen polykristalliner, für nachfolgendes Zonenschmelzen geeigneter Siliciumstäbe

- Zur großtechnischen Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie werden bevorzugt Solarzellen aus kristallinem Silicium eingesetzt. Dabei ist es wünschenswert, reines aber kostengünstiges Silicium einzusetzen, aus dem sich Solarzellen mit einem hohen Wirkungsgrad von beispielsweise mehr als 10 % herstellen lassen.
- 10
- 15 Zur Herstellung von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad wird heute allgemein hochreines Silicium als Grundmaterial verwendet, das durch thermische Zersetzung von mit Wasserstoff verdünntem, gasförmigen, hochreinen Siliciumverbindungen wie Silicochloroform oder Silicium-
- 20 tetrachlorid und Abscheidung auf widerstandsbeheizten Siliciumdünnstäben bei einer Temperatur von ca. 1100°C gewonnen wird. Die auf diese Weise hergestellten Siliciumpolystäbe werden durch anschließenden Kristallziehprozeß, z. B. durch tiegelfreies Zonenschmelzen, nachgereinigt, in einen Einkristall übergeführt, in
- 25 Scheiben zersägt, und zu Solarzellen weiterverarbeitet. Dieses Verfahren ist technisch relativ aufwendig und daher für großtechnische Siliciumherstellung zu teuer.
- 30 Silicium für technische Anwendungen mit einem zwar wesentlich niedrigeren Reinheitsgrad von beispielsweise 98,5 % wird heute großtechnisch durch Reduktion von Quarz mit Kohlenstoff im Lichtbogenofen hergestellt. Dieser Prozeß arbeitet zwar wirtschaftlich, er ist

jedoch nur dann zur Herstellung von Solarsilicium geeignet, wenn es gelingt, den bisher erzielten Reinheitsgrad entscheidend zu erhöhen.

5 Zu diesem Zweck wurde in der deutschen Patentanmeldung P 32 10 141.4 (VPA 82 P 1201 DE) bereits vorgeschlagen, das nach dem Lichtbogenverfahren gewonnene Silicium in Stabform überzuführen und durch anschließendes, tiegel-
10 freies Zonenschmelzen von den störenden Verunreinigungen zu befreien.

Die Praxis hat aber gezeigt, daß es nicht so ohne weiteres möglich ist, gegossenes Silicium durch Zonenschmelzen preiswert zu reinigen. Entweder wird im
15 Gegensatz zum durch thermische Zersetzung gewonnenes Silicium dieses mit vielen Rissen, Lunkern, Bläschen, Einschlüssen und sonstigen Kristallstörungen erhalten oder der Zonenschmelzprozeß muß sehr oft, manchmal mehr
20 als 6 bis 7 mal, wiederholt werden, um ein einigermaßen brauchbares Silicium zu erhalten.

Die Erfindung geht nun von der Erkenntnis aus, daß die technische Qualität des zonenbezogenen Solarsiliciums wesentlich verbessert werden kann, wenn das dem Zonenschmelzprozeß zu unterwerfende Silicium bereits höhere
25 Kristallqualität besitzt. Bei qualitativ höherwertigem Silicium gelingt es sogar mit wenigen Zonenzügen ver- setzungsfreies einkristallines Silicium zu gewinnen, das selbst für manche anspruchsvolleren Halbleiterbau-
30 elemente geeignet ist. Die Erfindung sieht daher vor; beim Herstellen polykristalliner, für nachfolgendes Zonenschmelzen geeignete Siliciumstäbe durch Gießen flüssigen Siliciums in formgebende Behältnisse mit anschließendem Erstarrenlassen den zonenzuschmelzenden

Siliciumstab bereits beim Gießen eine so hohe Kristallqualität zu verleihen, daß an die Kristallperfektionierung beim teureren Zonenschmelzen keine zu hohen Anforderungen mehr gestellt werden müssen.

5

Gemäß vorliegender Erfindung geschieht dies dadurch, daß die Siliciumschmelze in ein horizontal angeordnetes Boot gefüllt und danach mittels eines durch hierfür vorgesehene Zusatzheizer erzeugten, über die Bootlänge nahezu konstanten, vom Bootboden zur freien Oberfläche der Schmelze verlaufenden Temperaturgradienten gesteuert zum Erstarren gebracht wird, wobei der Temperaturgradient für die programmierte Abkühlung vom Bootboden zur freien Oberfläche hin durch zwei längs des Bootes verlaufende Heizvorrichtungen erzeugt wird. Die Erstarrungsgeschwindigkeit kann damit auf 1 bis 5 mm pro Minute eingestellt werden. Der stärkeren Abkühlung der Bootsenden kann dadurch wirksam begegnet werden, daß die Bootsenden stärker beheizt, also ein zusätzlicher in Längsrichtung des Bootes von den Bootenden zur Mitte hin verlaufender Temperaturgradient während des Erstarrens aufrechterhalten wird.

Der Gießvorgang selbst kann entweder im Vakuum oder im Schutzgas, z. B. Argon, bei reduziertem Druck durchgeführt werden. Bei Verwendung von Argon hat sich ein Partialdruck von 10 Torr als besonders günstig erwiesen.

Das gemäß der Erfindung vorgesehene gerichtete Erstarren der Siliciumschmelze bringt den großen Vorteil mit sich, Siliciumbarren mit hoher Reinheit zu erhalten. Es werden nämlich beim Erstarren der Schmelze ähnlich wie beim Zonenschmelzen die Verunreinigung mit der vom Bootboden zur freien Oberfläche hin wandernden Flüssig-Fest-Phase auch dorthin transportiert.

35

Der Vorgang der gerichteten Erstarrung gemäß vor-
liegender Erfindung hat aber dennoch mit dem Zonen-
schmelzen nichts gemein, bei dem bekanntlich eine durch
induktive Erwärmung erzeugte zwischen zwei festen Phasen
5 befindliche schmale schmelzflüssige Phase in Richtung
der Bootachse bewegt wird.

Nach dem Erkalten des Siliciumbarrens ist es ein
leichtes, die freie nahezu plane Oberfläche des er-
starrten Siliciumbarrens, in der sich der Großteil der
10 Verunreinigungen befindet, in an sich bekannter Weise
abzutragen, vorzugsweise abzuschleifen.

Obwohl jeder erhaltene Siliciumbarren einzeln dem
15 Zonenschmelzen unterworfen werden kann, sieht eine vor-
teilhafte Weiterbildung der Erfindung vor, zwei gegen-
einander gelegte und geeignet halbzylindrische Barren
gemeinsam dem Zonenschmelzverfahren zu unterziehen.

20 Die Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens besteht im wesentlichen aus einem horizontal
angeordneten Graphitboot, bei dem über seine Gesamtlänge
hinweg sowohl oberhalb als auch unterhalb des Bootes
eine in seiner Intensität getrennt steuerbare Heizvor-
25 richtung angeordnet ist. Die Heizvorrichtung besteht
im einfachsten Fall in einer der Bootsform angepaßten,
auch direkten Stromdurchgang erhitzten Graphitscheibe.
Sollen aber die Bootenden auf höhere Temperatur als im
Mittelbereich gebracht werden, ist es besser, als Heiz-
30 vorrichtung eine der Bootsform angepaßte Keramikscheibe,
die mit einzelnen Heizelementen bestückt ist, zu ver-
wenden.

Zweckmäßigerweise besitzt das Boot bei einer Länge von
35 50 bis 150 cm für die aufzunehmende Schmelze einen

nahezu halbkreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser von 30 bis 100 mm. Zur Vermeidung von Siliciumcarbidbildung ist es sinnvoll, die Bootsinnenseite entweder mit vergütetem Graphit oder mit Quarzsand zu beschichten.

Die Erfindung wird anhand zweier als Ausführungsbeispiele zu wertender Figuren näher erläutert.

10 Kernstück der Gießanordnung ist das horizontal angeordnete Graphitboot 1, das bei einer Länge von 100 cm einen Innendurchmesser von 75 mm für seinen halbkreisförmigen Querschnitt hat. Unterhalb des Bootes befindet sich die als Keramikscheibe 2 und oberhalb des Bootes
15 die als Keramikscheibe 3 ausgebildeten Heizungen. Beide Scheiben sind mit in der Figur nicht näher dargestellten Heizelementen bestückt. Sie sind unabhängig voneinander steuerbar, daß sie sowohl die Intensität in der Gesamtheit gleichmäßig zu regeln gestatten als auch mehrere
20 unterschiedlich stark beheizte Zonen bilden können, mit denen einzelne Bereiche, z. B. die Bootsenden, eine intensivere Beheizung erfahren können. Außer dieser individuellen Regelung eines jeden Heizkreises 2 bzw. 3 muß der Heizer 2 gegenüber dem Heizer 3 so gesteuert
25 werden, daß die Erstarrungsfront des in das Boot 1 eingefüllten flüssigen Siliciums 4 von unten, dem Gefäßboden, nach oben, der freien Oberfläche, fortschreitet.

Nach dem Erkalten wird der Siliciumbarren dem Boot entnommen und die nahezu ebene Oberfläche abgeschliffen,
30 die Stärke der abzutragenden Schicht wird im allgemeinen 2 mm kaum überschreiten müssen, sie hängt aber von der Reinheit des Ausgangsmaterials ab; auch die gewünschte Reinheit des Endproduktes muß in die Überlegung miteinbezogen werden, wenn der Aufwand beim nachfolgenden
35 Zonenschmelzen nicht zu groß werden darf.

5 Beim Zonenschmelzen können Kosten noch dadurch gespart werden, wenn, wie in Fig. 2 angedeutet, die beiden halbzyklindrischen Barren 5 und 6 mit den abgetragenen ebenen Oberflächen gegeneinander gelegt und geeignet vorgespannt gemeinsam zonengezogen werden, so daß ein einziger reiner und falls gewünscht auch versetzungs-freier einkristalliner Siliciumstab entsteht.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen polykristalliner, für nachfolgendes Zonenschmelzen geeigneter Siliciumstäbe durch Gießen flüssigen Siliciums in formgebende Behältnisse mit anschließendem Erstarrenlassen, d a -
5 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Siliciumschmelze in ein horizontal angeordnetes Boot gefüllt und danach mittels eines durch hierfür vorge-
sehene Zusatzheizer erzeugten, über die Bootlänge nahezu konstanten, vom Bootboden zur freien Oberfläche
10 der Schmelze verlaufenden Temperaturgradienten gesteuert zum Erstarren gebracht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t, daß der Temperaturgradient
15 für die programmierte Abkühlung vom Bootboden zur freien Oberfläche hin durch zwei längs des Bootes verlaufende Heizvorrichtungen erzeugt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, d a d u r c h
20 g e k e n n z e i c h n e t, daß die Erstarrungsgeschwindigkeit auf 1 bis 5 mm pro Minute eingestellt wird.
4. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3,
25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein zusätzlicher in Längsrichtung des Bootes von den Bootenden zur Mitte hin verlaufender Temperaturgradient während des Erstarrens aufrechterhalten wird.
- 30 5. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Gießvorgang im Vakuum durchgeführt wird.

6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Gießvorgang im Schutzgas, z. B. Argon, bei reduziertem Druck durchgeführt wird.
- 5
7. Verfahren nach Anspruch 6, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t, daß der Gießvorgang bei einem Argonpartialdruck von 10 Torr durchgeführt wird.
- 10
8. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die freie nahezu plane Oberfläche des gegossenen und erstarrten Siliciumbarrens abgetragen, vorzugsweise abgeschliffen wird.
- 15
9. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zwei gegeneinander gelegte und geeignet verspannte halbzylindrische Barren gemeinsam dem Zonenschmelzverfahren
- 20
10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein horizontal angeordnetes aus Graphit bestehendes Boot Verwendung findet, und daß
- 25
- sowohl oberhalb als auch unterhalb des Bootes über seine Gesamtlänge hinweg eine in seiner Intensität getrennt steuerbare Heizvorrichtung angeordnet ist.
- 30
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t, daß als Heizvorrichtung eine der Bootsform angepaßte durch direkten Stromdurchgang erhitzte Graphitscheibe vorgesehen ist.
- 35
12. Vorrichtung nach Anspruch 10, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t, daß als Heizvorrichtung

eine der Bootsform angepaßte mit Heizelementen versehene
Keramikscheibe vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 10
bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
5 daß die Heizelemente an den Bootsenden auf höhere
Temperatur als im Mittelbereich gebracht werden.

14. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
10 daß das Boot bei einer Länge von 50 bis 150 cm für die
aufzunehmende Schmelze einen nahezu halbkreisförmigen
Querschnitt mit einem Durchmesser von 30 bis 100 mm
besitzt.

15 15. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß die Bootsinnenseite mit vergütetem Graphit be-
schichtet ist.

20 16. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß die Bootsinnenseite mit Quarzsand beschichtet ist.

FIG 1

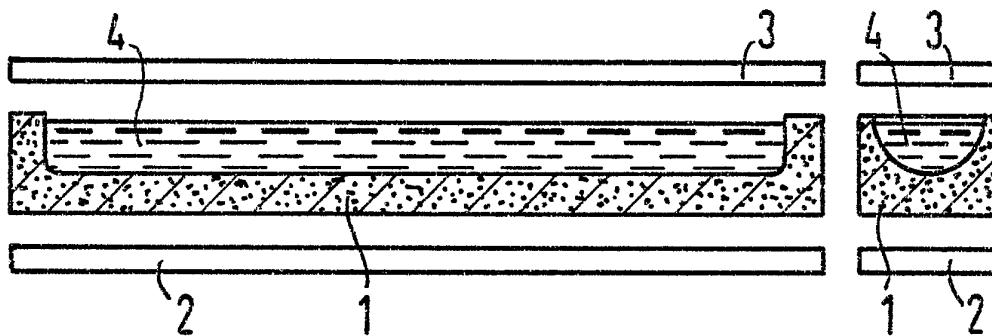


FIG 2

